

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005年4月14日 (14.04.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/033188 A1

(51) 国際特許分類⁷: C08J 5/18, C08L 71/10,
C08K 3/00, B29C 47/88, G03G 15/00, 15/02, 15/16 //
B29K 71:00, 105:16

Fukushima (JP). 鈴木 康浩 (SUZUKI, Yasuhiro) [JP/JP];
〒9748686 福島県いわき市錦町落合 1 6 呉羽化学工
業株式会社錦総合研究所内 Fukushima (JP).

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/014899

(74) 代理人: 西川 繁明 (NISHIKAWA, Shigeaki); 〒1160014
東京都荒川区東日暮里三丁目 4 3 番 9 号 ビジュー
ル・シティー 4 0 1 号 Tokyo (JP).

(22) 国際出願日: 2004 年 10 月 1 日 (01.10.2004)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が
可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,
BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,
ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT,
LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI,
NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG,
SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ,
VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2003-346851 2003 年 10 月 6 日 (06.10.2003) JP

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可
能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD,
SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY,
KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG,
CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,
IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF,
BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN,
TD, TG).

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 呉羽化
学工業株式会社 (KUREHA CHEMICAL INDUSTRY
COMPANY, LIMITED) [JP/JP]; 〒1038552 東京都中
央区日本橋堀留町一丁目 9 番 1 1 号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 北村 秀樹 (KI-
TAMURA, Hideki) [JP/JP]; 〒9748686 福島県いわき市
錦町落合 1 6 呉羽化学工業株式会社錦総合研究所内
Fukushima (JP). 寺本 嘉吉 (TERAMOTO, Yoshikichi)
[JP/JP]; 〒9748686 福島県いわき市錦町落合 1 6 呉
羽化学工業株式会社錦総合研究所内 Fukushima (JP).
鈴木 和元 (SUZUKI, Kazuyuki) [JP/JP]; 〒9748686 福
島県いわき市錦町落合 1 6 呉羽化学工業株式会社
錦総合研究所内 Fukushima (JP). 西畑 直光 (NISHI-
HATA, Naomitsu) [JP/JP]; 〒9748686 福島県いわき市
錦町落合 1 6 呉羽化学工業株式会社錦総合研究所内

添付公開書類:
— 国際調査報告書

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される
各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語
のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: SEMICONDUCTIVE FILM, ELECTRIC CHARGE CONTROL MEMBER AND PROCESS FOR PRODUCING THE SEMICONDUCTIVE FILM

(54) 発明の名称: 半導電性フィルム、電荷制御部材、及び半導電性フィルムの製造方法

(57) Abstract: A semiconductive film from a resin composition comprising a polyether ether ketone and a conductive filler. The semiconductive film has an average thickness of 30 to 250 μm , and the thickness maximum is in the range of 1 to 1.3 times the thickness minimum. The semiconductive film has an average volume resistivity of 1.0×10^2 to $1.0 \times 10^{14} \Omega\text{cm}$, and the volume resistivity maximum is in the range of 1 to 30 times the volume resistivity minimum. With respect to the semiconductive film, the number of reciprocating flexes measured by flexing resistance test is 5000 flexes or more. There is further provided a process for producing the same.

(57) 要約: ポリエーテルエーテルケトンと導電性フィラーを含有する樹脂組成物から形成された半導電性フィルムであって、厚みの平均値が $30 \sim 250 \mu\text{m}$ かつ厚みの最大値が最小値の $1 \sim 1.3$ 倍であり、体積抵抗率の平均値が $1.0 \times 10^2 \sim 1.0 \times 10^{14} \Omega\text{cm}$ かつ体積抵抗率の最大値が最小値の $1 \sim 30$ 倍であり、耐折強さ試験法により測定した往復折り曲げ回数が $5,000$ 回以上である半導電性フィルム、並びにその製造方法。

WO 2005/033188 A1